# 半導体との一体化　4

## CMOSプロセスで集積化されたカンチレバー

by J. Verd et al.

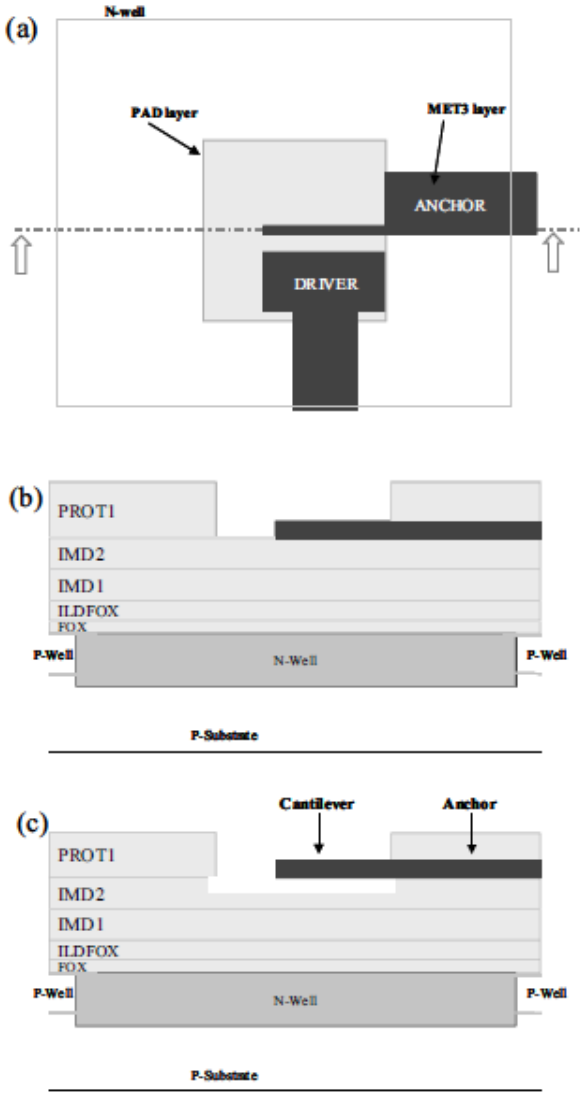


*Figure 2. Schematic top view showing the CMOS technology layers used (a) and schematic cross-section view after standard CMOS process (b) and after the post-CMOS process (sacrificial layer etching) (c).*

0．35μmルールの
CMOSプロセスにより、
カンチレバーとそこから
の容量信号を読み出す
CMOS回路を集積した。

ポストプロセス
0．35μmルールの
CMOSプロセスにより、
高感度な容量型の触覚
センサを開発した。

## CMOSプロセスによる触覚センサ　by K.R. Lee et al.

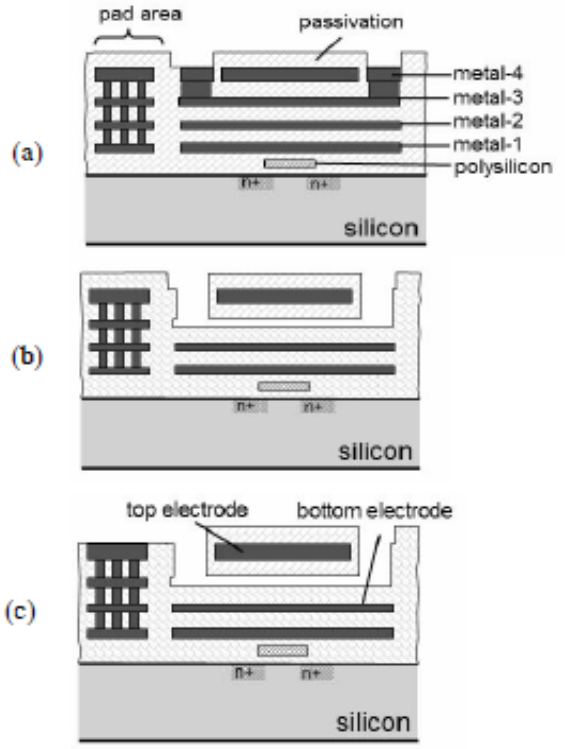


*Figure 1: The post CMOS micromachining process.*

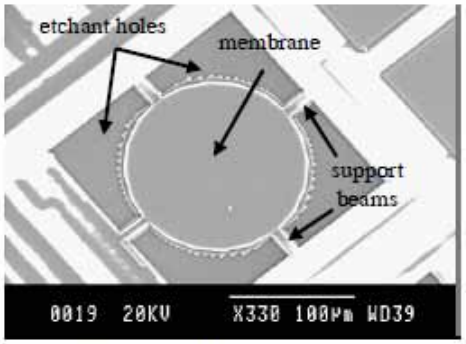


*Figure 2: SEM of the fabricated tactile sensor with a radius of 75 μm. The support beams are 25 μm by 10 μm.*